

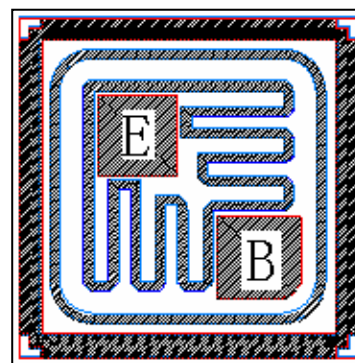


5401 晶体管芯片说明书

■ 芯片简介

芯片尺寸：4 英寸（100mm）
芯片代码：A043BJ-01
芯片厚度：240±20μm
管芯尺寸：430×430μm²
焊位尺寸：B 极 107×107μm²，E 极 101×101μm²
电极金属：铝
背面金属：金
典型封装：2N5401，H5401

■ 管芯示意图



■ 极限值 (T_a=25°C) (封装形式：TO-92)

T_{stg}——贮存温度…………… -55~150°C
T_j——结温……………150°C
P_C——集电极耗散功率……………625mW
V_{CBO}——集电极—基极电压……………-160V
V_{CEO}——集电极—发射极电压……………-150V
V_{EBO}——发射极—基极电压……………-5V
I_C——集电极电流……………-600mA

■ 电参数 (T_a=25°C) (封装形式：TO-92)

参数符号	符 号 说 明	最小值	典型值	最大值	单位	测 试 条 件
I _{CBO}	集电极—基极截止电流			-0.05	μA	V _{CB} =-120V, I _E =0
I _{EBO}	发射极—基极截止电流			-0.05	μA	V _{EB} =-3V, I _C =0
h _{FE}	直流电流增益	30				V _{CE} =-5V, I _C =-1mA
		60		280		V _{CE} =-5V, I _C =-10mA
		50				V _{CE} =-5V, I _C =-50mA
V _{CE(sat)}	集电极—发射极饱和电压			-0.2	V	I _C =-10mA, I _B =-1mA
				-0.5	V	I _C =-50mA, I _B =-5mA
V _{BE(sat)}	基极—发射极饱和电压			-1	V	I _C =-10mA, I _B =-1mA
				-1	V	I _C =-50mA, I _B =-5mA
BV _{CBO}	集电极—基极击穿电压	-160			V	I _C =-100μA, I _E =0
BV _{CEO}	集电极—发射极击穿电压	-150			V	I _C =-1mA, I _B =0
BV _{EBO}	发射极—基极击穿电压	-5			V	I _E =-10μA, I _C =0
f _T	特征频率	100		400	MHz	V _{CE} =-10V, I _C =-10mA f=100MHz